

Содержание

Миронов С.Г., Поплавская Т.В., Кириловский С.В., Маслов А.А.

Критерий подобия сверхзвукового обтекания цилиндра с передней высокопористой ячеистой вставкой 3

Иванов П.А., Потапов А.С., Кудояров М.Ф., Козловский М.А., Самсонова Т.П.

Влияние термообработки на электрические характеристики полупроводниковых слоев, полученных с помощью облучения n -SiC высокоэнергетическими ионами аргона 11

Глинский Г.Ф.

Простой численный метод определения энергетического спектра носителей заряда в полупроводниковых гетероструктурах 17

Кавеева Е.Г., Рожанский В.А.

Дрейфовый механизм формирования обдирочного слоя в токамаке 25

Грибкова О.Л., Сафьянова Л.В., Тамеев А.Р., Лыпенко Д.А., Тверской В.А., Некрасов А.А.

Водорастворимый комплекс полианилина для формирования оптоэлектронных устройств методом струйной печати 34

Старков А.С., Пахомов О.В., Родионов В.В., Амиров А.А., Старков И.А.

Оценка термодинамической эффективности твердотельного охладителя на основе мультикалорического эффекта 42

Бенеманская Г.В., Лапушкин М.Н., Марченко Д.Е., Тимошнев С.Н.

Электронная структура нанointерфейса Cs/ n -GaN(0001) 50

Громов М.Б., Кузнецов Д.С., Мурченко А.Е., Новикова Г.Я., Обиных Б.А., Оралбаев А.Ю., Плакитина К.В., Скорохватов М.Д., Сухотин С.В., Чепурнов А.С., Этенко А.В.

Изучение стабильности образцов гадолинизированного жидкого органического сцинтиллятора 59

Сениченков И.Ю., Кавеева Е.Г., Рожанский В.А., Сытова Е.А., Веселова И.Ю., Воскобойников С.П., Coster D.P.

Роль электрического поля в формировании режима отрыва плазмы токамака 66

Протасов Д.Ю., Гуляев Д.В., Бакаров А.К., Торопов А.И., Ерофеев Е.В., Журавлев К.С.

Увеличение насыщенной скорости дрейфа электронов в рНЕМТ-гетероструктурах с донорно-акцепторным легированием 77

Литвиненко А.Н., Гришин С.В., Шараевский Ю.П., Тихонов В.В., Никитов С.А.

Магнитоакустический генератор хаотических колебаний с задержкой и бистабильностью 85

Сорокин С.В., Седова И.В., Беляев К.Г., Рахлин М.В., Яговкина М.А., Торопов А.А., Иванов С.В.

Наногетероструктуры с квантовыми точками CdTe/ZnMgSeTe для однофотонных источников, формируемые методом молекулярно-пучковой эпитаксии 94

Новодворский О.А., Михалевский В.А., Гусев Д.С., Лотин А.А., Паршина Л.С., Храмова О.Д., Черобыло Е.А.

Времяпролетные характеристики лазерного факела при абляции мишени MnSi в атмосфере аргона 103